

单位: mil

## LPVBG27B

### 产品特性:

尺寸  
芯片尺寸: 11mil x 27mil  
(278±25μm x 686±25μm)

芯片厚度: 4.1mil(105±15μm)  
焊盘尺寸: 3.0mil(75±10μm)

焊盘金属  
P焊盘: 金  
N焊盘: 金



LatticePower

## 产品介绍

Product Introduction

# LPVBG27B



LatticePower

## 产品介绍

Product Introduction

# LPVBG27B

### 最大值

DC 正向电流	30mA
正向峰值电流(1/10占空比@1kHz)	50mA
LED结温	115℃
反向电压	5V
使用温度范围	-40~85℃
贮存温度范围	0~40℃

### 说明:

1. 最大额定值为晶能光电封装条件下测试得到, 不同封装形式得到的值会有所不同, 建议在不超过最大额定值的条件下使用, 超过最大额定值使用可能会引起LED芯片毁坏。
2. 本产品非设计与反向电流(压)下使用, 不建议在任何反向电流(压)下使用。

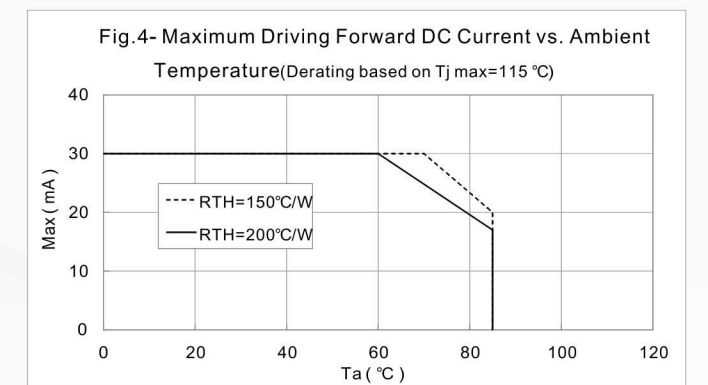
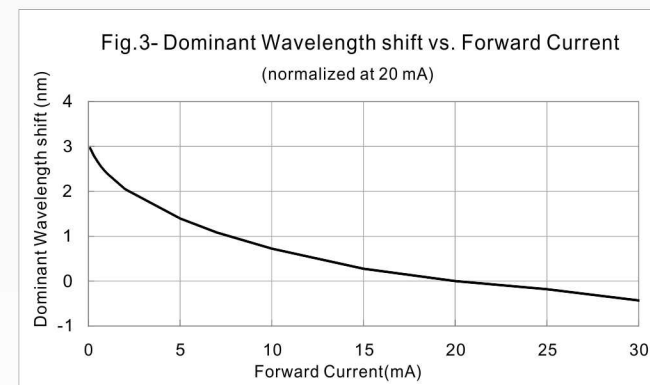
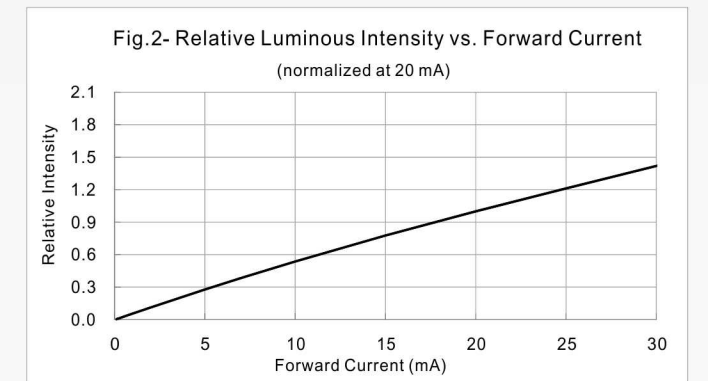
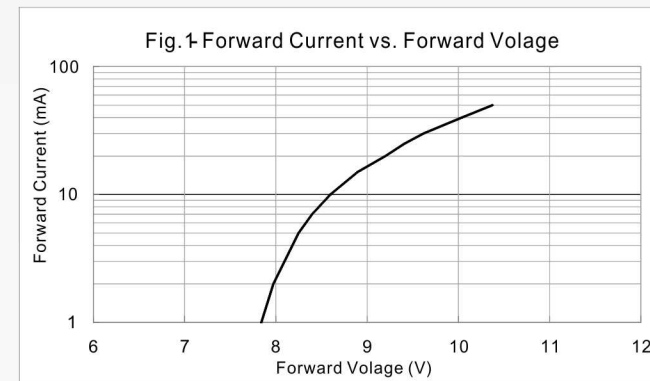
### 光电参数

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
开启电压	V <sub>f1</sub>	I <sub>f</sub> =10μA	6	---	8	V
工作电压	V <sub>f2</sub>	I <sub>f</sub> =20mA	8	---	10	V
主波长	λ <sub>d</sub>	I <sub>f</sub> =20mA	445	---	475	nm
半波宽度	Δλ	I <sub>f</sub> =20mA	---	---	30	nm
光功率	P <sub>o</sub>	I <sub>f</sub> =20mA	80	---	120	mW

### 参数等级

Wd(nm) Po(mW)	447.5-450	450-452.5	452.5-455	455-457.5	457.5-460	460-462.5
110-120	FBFW	GAFW	GBFW	HAFW	HBFW	IAFW
100-110	FBEW	GAEW	GBEW	HAEW	HBEW	IAEW
95-100	FBHV	GAHV	GBHV	HAHV	HBHV	IAHV
90-95	FBGV	GAGV	GBGV	HAGV	HBGV	IAGV
85-90	FBFV	GAFV	GBFV	HAFV	HBFV	IAFV
80-85	FBEV	GAEV	GBEV	HAEV	HBEV	IAEV

### 特性曲线



### 其它说明:

1. 光电参数为采用晶能光电测试仪器在室温下(T<sub>A</sub>=25℃)测试结果;
2. GaN芯片为静电敏感产品, 请在使用、运输时注意静电保护;
3. 可根据客户要求订做特殊规格芯片。

LatticePower

LatticePower